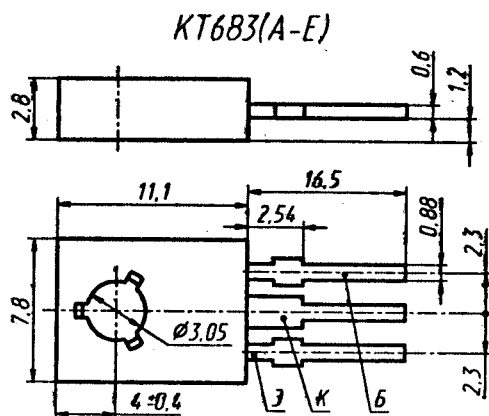


КТ683А, КТ683Б, КТ683В, КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е

Транзисторы кремниевые планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 0,15$ А:

КТ683А, КТ683В, КТ683Г 40...120

КТ683Б, КТ683Д 80...240

КТ683Е 160...480

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 10$ В, $I_3 = 50$ мА, не менее 50 МГц

Граничное напряжение при $I_3 = 30$ мА, не менее:

КТ683А 90 В

КТ683Б, КТ683В 80 В

КТ683Г 60 В

КТ683Д, КТ683Е 40 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 0,15$ А, $I_б = 15$ мА, не более 0,45 В

Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 0,15$ А, $I_б = 15$ мА, не более 1 В

Пробивное напряжение коллектор—эмиттер при $I_k = 0,1$ мА, $R_{бз} = 3$ кОм, не менее:

КТ683А 150 В

КТ683Б, КТ683В 120 В

КТ683Г 100 В

КТ683Д, КТ683Е 60 В

Пробивное напряжение база—эмиттер при $I_3 = 0,1$ мА, не менее:

КТ683А, КТ683Б, КТ683В 7 В

КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е 5 В

Время включения при $U_{кз} = 40$ В, $I_k = 0,2$ А, $I_б = 40$ мА, типовое значение 0,1* мкс

Время выключения при $U_{кз} = 40$ В, $I_k = 0,2$ А, $I_б = 40$ мА, типовое значение 0,2* мкс

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10$ В, не более 15* пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5$ В, не более 65* пФ

Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 90$ В для КТ683А, КТ683Б, КТ683В и 40 В для КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е, не более 1 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:

при $R_{БЭ} = 3 \text{ кОм}$:

КТ683А	150 В
КТ683Б, КТ683В	120 В
КТ683Г	100 В
КТ683Д, КТ683Е	60 В

при $R_{БЭ} = \infty$:

КТ683А	90 В
КТ683Б, КТ683В	80 В
КТ683Г	60 В
КТ683Д, КТ683Е	40 В

Постоянное напряжение база—эмиттер:

КТ683А, КТ683Б, КТ683В	7 В
КТ683Г, КТ683Д, КТ683Е	5 В

Постоянный ток коллектора

1 А

Импульсный ток коллектора при $t_n = 1 \text{ мс}$

2 А

Постоянный ток базы

0,2 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T_K = -60...+25 \text{ }^\circ\text{C}$:

с теплоотводом

8 Вт

без теплоотвода

1,2 Вт

Температура p - n перехода

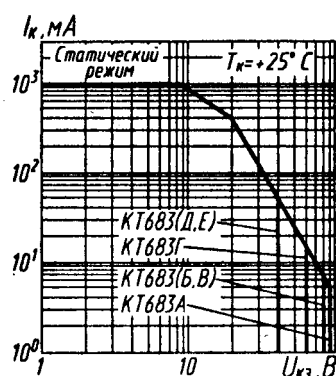
+150 $^\circ\text{C}$

Температура окружающей среды

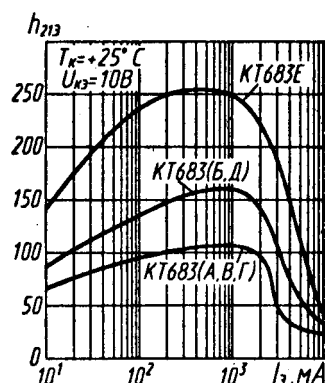
-60... $T_K =$

= +125 $^\circ\text{C}$

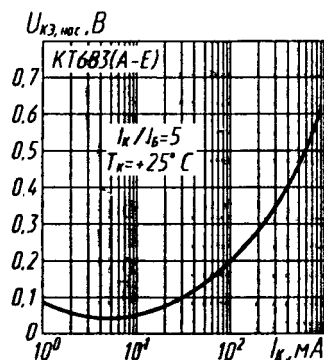
¹ При $T_K \geq 25 \text{ }^\circ\text{C}$ $P_{K, \text{макс}}$ снижается линейно на 0,064 Вт/ $^\circ\text{C}$ с теплоотводом и на 0,0096 Вт/ $^\circ\text{C}$ без теплоотвода.



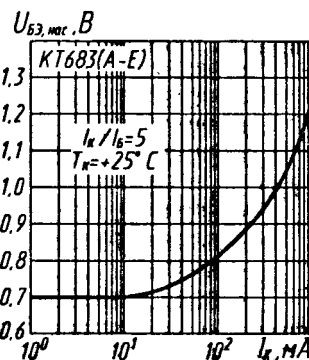
Области безопасной работы транзисторов



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора